



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HSBD176

对应国外型号
BD176

主要用途

中功率线性开关

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} —— 贮存温度	-55~150
T_j —— 结温	150
P_C —— 集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	30W
V_{CBO} —— 集电极—基极电压	-45V
V_{CEO} —— 集电极—发射极电压	-45V
V_{EBO} —— 发射极—基极电压	-5V
I_C —— 集电极电流(Pulse)	-7A
I_C —— 集电极电流(DC)	-3A

外形图及引脚排列



电参数 ($T_c=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-100	μA	$V_{CB}=-45\text{V}, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	mA	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$
* $h_{FE(1)}$	直流电流增益(1)	40		250		$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-150\text{mA}$
* $h_{FE(2)}$	直流电流增益(2)	15				$V_{CE}=-2\text{V}, I_C=-1\text{A}$
* $V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和压降			-0.8	V	$I_C=-1\text{A}, I_B=-0.1\text{A}$
* $V_{BE(ON)}$	基极—发射极导通压降			-1.3	V	$I_C=-1\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}$
$V_{CEO(SUS)}$	集电极—发射极维持电压	-45				$I_C=-100\text{mA}, I_B=0$
f_T	特征频率	3			MHz	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-250\text{mA}$

*Pulse Test: PW=300 μs , Duty Cycle $\leq 1.5\%$ Pulse

$h_{FE(1)}$ 分档及其标志

Cassification	6	10	16
$h_{FE(1)}$	40~100	63~160	100~250